

Спосіб вирощування $\text{CuBiP}_2\text{Se}_6$ методом спрямованої кристалізації з розплаву включає ступінчасте нагрівання вакуумованих кварцових ампул, які містять елементарні компоненти: вісмут, фосфор та селен, взяті у стехіометричному співвідношенні. Вирощують $\text{CuBiP}_2\text{Se}_6$ у вакуумованих кварцових ампулах методом спрямованої кристалізації з розплаву при температурі 860 К і витримці при цій температурі протягом 24 год, а також зони відпалу 630 К із подальшим відпалом протягом 48 год для гомогенізації розплаву одержаної шихти зі швидкістю вирощування 0,4-0,5 мм/год, після чого охолоджують монокристал до кімнатної температури зі швидкістю 4-5 К/год.